

Оптические свидетельства совместимости антиферромагнетизма и сверхпроводимости в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$

В. В. Еременко, В. Н. Самоваров, В. Л. Вакула, М. Ю. Либин,
С. А. Уютнов

*Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина НАН Украины,
Украина, 61164, г. Харьков, пр. Ленина, 47
E-mail: eremenko@ilt.kharkov.ua*

Статья поступила в редакцию 18 апреля 2000 г.

Проведены измерения эволюции спектрального состава поглощения в области (1,25–2,6) эВ металлических пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ с температурами сверхпроводящих переходов $T_c = 51$ и 74 К при их охлаждении от 180 до 20 К. Особое внимание уделено температурным изменениям двух полос поглощения: А-полосы ($\approx 1,8$ эВ), отражающей появление дырок, одетых в «шубу» антиферромагнитных (АФ) флуктуаций и (А + J)-полосы ($\approx 2,15$ эВ), отражающей дополнительное (магнонное) возбуждение ближнего АФ порядка. Обнаружено, что изменения этих полос начинаются в нормальной фазе при $T < T^*$ в температурной области открытия псевдощелевого состояния, причем магнонная полоса (А + J) возникает в псевдощелевом состоянии даже в случае ее отсутствия при комнатных температурах. При сверхпроводящем переходе параметры полос перестают изменяться, и магнонная (А + J)-полоса в сверхпроводящей фазе сохраняется. Полученные результаты трактуются как свидетельство магнитной природы псевдощелевого состояния и совместимости АФ ближнего порядка со сверхпроводимостью.

Проведено вимірювання еволюції спектрального складу поглинання в області (1,25–2,6) еВ металевих плівок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ з температурами надпровідних переходів $T_c = 51$ та 74 К при їх охолодженні від 180 до 20 К. Особливу увагу приділено температурним змінам двох смуг поглинання: А-смуги ($\approx 1,8$ еВ), яка свідчить про появу дірок, вдягнених в «шубу» антиферромагнітних (АФ) флуктуацій, та (А + J)-смуги ($\approx 2,15$ еВ), яка свідчить про додаткове (магнонне) збудження ближнього АФ упорядкування. Установлено, що зміни цих смуг починаються в нормальній фазі при $T < T^*$ в температурній області відкриття псевдоцилінрного стану, до того ж магнонна смуга (А + J) виникає в псевдоцилінрному стані навіть у випадку її відсутності при кімнатних температурах. При надпровідному переході параметри смуг припиняють змінюватися, і магнонна (А + J)-смуга в надпровідній фазі зберігається. Одержані результати трактуються як свідчення магнітної природи псевдоцилінрного стану та сумісності АФ близького порядку з надпровідністю.

PACS: 74.72.Bk, 74.72.Dn

Введение

В настоящее время установлено, что в купратных ВТСП при их охлаждении сначала реализуется переход в состояние с псевдощелью в спектре электронных возбуждений, а затем переход в сверхпроводящее (СП) состояние. Псевдощелевое состояние, будучи прекурсорным к сверхпроводимости, привлекает повышенное внимание и широко исследуется, например, методами спин-эха, ядерной релаксации, фотоэмиссионной спек-

троскопии углового разрешения (см. обзоры [1–3]). В частности, эти эксперименты показывают, что максимальному значению псевдощели отвечает окрестность точки $(\pi, 0)$ в 2D зоне Бриллюэна. В направлении диагонали зоны псевдощель отсутствует. Влияние псевдощели регистрируется при температуре ниже T^* , которая в зависимости от уровня допирования купратных ВТСП близка или заметно превышает критическую T_c . Вблизи оптимального уровня допирования максимальные

значения СП щели Δ_s и псевдощели Δ^* примерно равны, $\Delta \approx 40$ мэВ [1], причем обе щелевые особенности, по-видимому, имеют пространственную симметрию d -типа [1–3].

В итоге можно считать, что в купратных ВТСП образование СП фазы «стартует» при $T = T^*$ и в самой критической точке СП щель, в отличие от классических сверхпроводников, не обращается в нуль. В теоретических исследованиях псевдощелевого состояния можно выделить два альтернативных подхода: на основе формирования выше T_c куперовских пар [4] и решающей роли флуктуаций ближнего антиферромагнитного (АФ) порядка [5] (псевдощель в спектре спиновых возбуждений). В любом случае экспериментальное и теоретическое изучение проблемы высокотемпературной сверхпроводимости в купратных ВТСП должно включать совместное рассмотрение псевдощелевых аномалий при $T_c < T \leq T^*$ и собственно СП состояния при $T \leq T_c$.

Целью настоящей работы было исследование в видимом диапазоне частот 1,25–2,6 эВ поведения спектров поглощения пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ при температурном прохождении как псевдощелевого, так и СП состояний. Такая постановка эксперимента является, вообще говоря, весьма необычной, поскольку энергия квантов света в используемой нами рабочей области частот значительно превышает величины обеих щелевых особенностей ($\hbar\omega \gg \Delta_s, \Delta^*$). В классических сверхпроводниках информативный для изучения сверхпроводимости диапазон оптического поглощения (отражения) лежит, как известно, вблизи энергии СП щели $\hbar\omega \approx \Delta_s$. Если в электронном спектре нормальной фазы при понижении температуры образуется энергетическая щель иной природы, например для магнитных возбуждений, величиной Δ_{mag} , то оптический отклик на эти изменения также появляется на частотах близких к Δ_{mag} . Так, в U_2RuSi_2 ($T_c \approx 1,5$ К) при $T < T^* \approx 20$ К значения оптической проводимости из-за открытия магнитной щели уменьшаются в низкочастотной области спектра $\hbar\omega \approx \Delta_{\text{mag}} \approx 10$ мэВ, но выше по энергии уровень оптической проводимости (отражения) не изменяется [6]. Подобная картина «подавления» оптической проводимости наблюдается в купратных ВТСП (YBCO , Bi2212 , LSCO) в низкочастотной области $\hbar\omega < 2\Delta^* \approx 100$ мэВ [1], когда при $T < T^*$ в этих соединениях возникает псевдощель в плотности состояний.

При разработке спектроскопической задачи изучения псевдощелевого и СП состояний в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ с помощью высокоэнергетических квантов света $\hbar\omega \gg \Delta_s, \Delta^*$ мы опирались на два

важных результата предыдущих оптических исследований. Во-первых, уже сравнительно давно показано, что при фиксированных частотах видимого и инфракрасного диапазонов имеются резкие изломы сигнала поглощения на СП переходе при охлаждении пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ [7,8]. Аномалии в температурном ходе интенсивности поглощения для $\hbar\omega = 2$ эВ в пленках $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ при различном допировании были также отмечены вблизи $T^* \approx 110$ К (при $T_c \approx 90$ К) и $T^* \approx 160$ К (при $T_c \approx 50$ К) [9]. Однако детальные исследования температурной эволюции спектрального состава многокомпонентного контура поглощения $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ в области энергий $\hbar\omega \geq 1,25$ эВ не проводились. Во-вторых, мы руководствовались результатами нашей предыдущей работы [10] по изучению и анализу спектров поглощения пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ в зависимости от уровня допирования при 300 К. В [10] было показано, что в области $\hbar\omega = 1,25$ –3 эВ спектр поглощения, являясь многокомпонентным, содержит особенности (оптические «метки»), которые «отслеживают» при допировании степень pd -гибридизации (ковалентности) и взаимодействие тяжелых носителей заряда с магнитной подсистемой. Так, степень pd -гибридизации влияет на параметры полосы поглощения B_d^1 ($\approx 1,5$ эВ), обязанной $d_{xy} \rightarrow d_{x^2-y^2}$ -переходу в спектре иона Cu^{2+} . В то же время полосы поглощения A ($\approx 1,8$ эВ) и $(A + J)$ ($\approx 2,1$ эВ) чувствительны к АФ упорядочению (АФ флуктуациям). В частности, $(A + J)$ -полоса отражает вероятность двухмагнетонного возбуждения при межзонных переходах с переносом заряда. С увеличением допирования при 300 К в металлической фазе ковалентный и магнитный (корреляционный) вклады в спектр носителей заряда конкурируют между собой: A - и $(A + J)$ -полосы уменьшаются по интенсивности и уширяются, но B_d^1 -полоса при металлизации усиливается.

При охлаждении от 300 К поведение этих полос необязательно должно следовать тому же сценарию, что и при допировании. Можно ожидать нескольких вариантов взаимных изменений A -, $(A + J)$ - и B_d^1 -полос поглощения в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ при прохождении псевдощелевого, а затем СП состояний. Например, температурные изменения для какой-либо из указанных полос поглощения могут вообще отсутствовать. За каждым из этих сценариев стоят определенные механизмы возникновения псевдощелевого состояния, а также альтернативные возможности конкуренции (сосуществования) АФ магнитного упорядочения и сверхпроводимости. Экспериментальные данные,

полученные в настоящей работе, показывают, что спектральный состав поглощения света при охлаждении $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ развивается таким образом, что можно утверждать о совместности антиферромагнетизма и сверхпроводимости в этом материале. Так, A -полоса поглощения, связанная с АФ флуктуациями, и $(A + J)$ -полоса поглощения, отражающая возбуждение магнонов в металле, усиливаются в псевдощелевом состоянии и сохраняются в сверхпроводящей фазе. В целом анализ имеющихся данных свидетельствует в пользу спин-волновой природы высокотемпературной сверхпроводимости.

Общий подход к анализу спектров и эксперимент

Прежде чем привести экспериментальные результаты и обсудить их, изложим наш подход к идентификации спектров поглощения.

В области энергий $\hbar\omega = 1-3$ эВ спектр поглощения $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ при поляризации света $\mathbf{E} \parallel ab$ является многокомпонентным. В этот спектральный интервал попадают оптические переходы разной природы: внутризонные, межзонные и локальные dd -переходы в ионах Cu^{2+} . Для идентификации переходов рассмотрим структуру плотности состояний $N(E)$, которая является

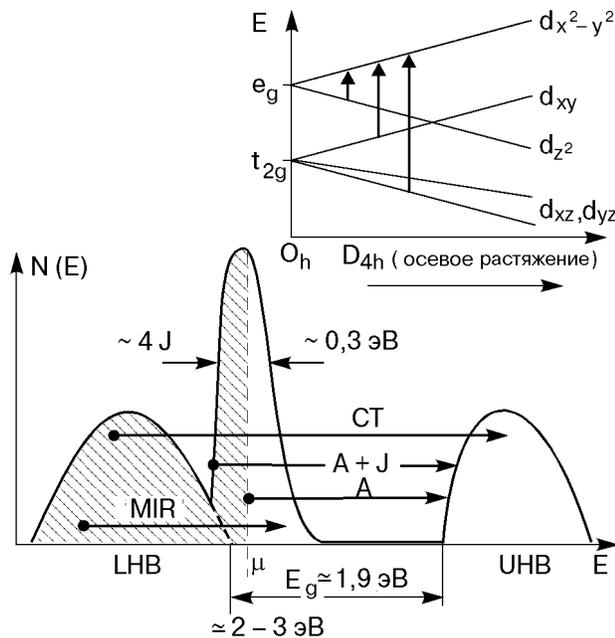


Рис. 1. Схематическое изображение расщепления d -уровней иона Cu^{2+} в кристаллическом поле тетрагональной симметрии D_{4h} и распределение плотности состояний $N(E)$ в медно-оксидных ВТСП с дырочным типом допирования. Стрелками указаны оптические переходы, рассматриваемые при анализе измеренных спектров поглощения. Уровни энергии указаны без соблюдения масштаба.

общей для медно-оксидных ВТСП. Она показана на рис. 1 вместе со схемой расщепления уровней Cu^{2+} в тетрагональном поле кислородных p -лигандов. Стрелками отмечены возможные переходы в металлической фазе.

Картина распределения плотности состояний определяется в купратных ВТСП электронными (хаббардовскими) корреляциями и особенностями медь-кислородных взаимодействий. Нижняя pd -гибридизованная хаббардовская зона (ЛНВ) отделена от верхней хаббардовской зоны (УНВ), образованной преимущественно d -орбиталями меди, оптической щелью величиной E_g . Природа щели обусловлена переносом заряда от ионов кислорода к меди. Для диэлектрика $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ с уровнем допирования $x \approx 0,3$ величина $E_g \approx 1,7$ эВ [11]. На вершине нижней хаббардовской зоны в металлической фазе возникает квазичастичный пик плотности состояний, в котором расположен химический потенциал. Для модели взаимодействия дырочных носителей заряда с антиферромагнитными флуктуациями квазичастичный пик характеризует тяжелые носители, одетые в «шубу» АФ флуктуаций [3,12,13]. В $2D$ зоне Бриллюэна наиболее сильное взаимодействие носителей заряда с АФ флуктуациями реализуется вдоль Γ - M -направления, но вдоль других направлений квазиимпульса это взаимодействие ослаблено. Характерная ширина квазичастичного (когерентного) A -пика составляет приблизительно $(3-4)J$, где $J \approx 10^3$ К — энергия обменного взаимодействия в плоскости CuO_2 для $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ [2]. Полная ширина валентной нижней хаббардовской зоны ≈ 2 эВ.

Следующие четыре типа оптических переходов в металлической фазе естественным образом возникают в рамках представленной $N(E)$. В области выше порога поглощения $\hbar\omega \geq E_g$ появляется континуальная компонента межзонных переходов с переносом заряда, в дальнейшем ПЗ-переходы (charge transfer (CT) transitions). Вблизи порога E_g возможны электронные переходы двух типов, связанные с квазичастичным A -пиком в плотности состояний (см. рис. 1). Во-первых, это переходы через оптическую щель без возбуждения магнитных степеней свободы (в дальнейшем A -переход) и, во-вторых, более высокочастотные с одновременным переносом заряда и возбуждением магнитной подсистемы (в дальнейшем $(A + J)$ -переход). Все эти переходы должны проявляться в спектрах в виде сравнительно узкополосных спектральных контуров с ширинами масштаба энергии J . Наконец, возможны внутризонные переходы из глубины валентной зоны в откры-

вающуюся с допированием область дырочных состояний. Их спектральный вес в основном сосредоточен в средней инфракрасной области, СИК (MIR)-переходы. Красная граница СИК-переходов должна иметь значение, близкое к ширине A -пика, т. е. $\approx 0,3-0,4$ эВ, но коротковолновое крыло может простираться по энергии на всю ширину валентной зоны и захватывать даже видимый диапазон. В экспериментах с металлизированными пленками $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ ($x > 0,4$) асимметричный СИК-контур поглощения имеет максимум вблизи 0,6 эВ и медленно спадающее вплоть до 3 эВ коротковолновое крыло [8,10].

Что касается dd -переходов в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$, то для поляризации $\mathbf{E} \parallel ab$ наибольший вклад в поглощение дают переходы $d_{xy} \rightarrow d_{x^2-y^2}$ и $d_{yz,xz} \rightarrow d_{x^2-y^2}$. При слабой pd -гибридизации (степени ковалентности) dd -переходы в силу симметричного правила запрета приводят к слабоинтенсивным полосам с коэффициентами поглощения в диэлектрической фазе $\alpha \approx 10^4 \text{ см}^{-1}$ [10,14]. В этом случае dd -переходы хорошо проявляются в спектрах комбинационного рассеяния (КР). Например, в спектрах КР переход $d_{xy} \rightarrow d_{x^2-y^2}$ отчетливо выражен в диэлектрической фазе $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ ($x \leq 0,4$) в виде полосы, центрированной вблизи 1,5 эВ [15]. С усилением pd -гибридизации в металле коэффициент поглощения для dd -переходов возрастает до значений, сравнимых с коэффициентами для ПЗ-переходов, $\alpha \approx 10^5 \text{ см}^{-1}$ [10], но в спектрах КР эти переходы при металлизации сильно ослабляются [15].

Изложенные положения были ранее использованы при анализе эволюции спектрального состава поглощения тонких пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ ($\mathbf{E} \parallel ab$) при их допировании [10]. Было показано, что указанные шесть переходов (ПЗ, A , $A+J$, $d_{xy} \rightarrow d_{x^2-y^2}$, $d_{yz,xz} \rightarrow d_{x^2-y^2}$ и СИК) с точностью не хуже 5% описывают многокомпонентный спектр поглощения пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ как в диэлектрической ($x \approx 0,35$), так и в металлической фазе в области $x = 0,5-0,9$.

Наиболее простым при 300 К является спектр поглощения $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ в диэлектрической фазе. Так, на границе перехода к металлу при $x \approx 0,35$ в спектральной области 1,25–3 эВ доминируют только гауссовы контуры от A -перехода, $(A+J)$ -перехода и континуальная ПЗ компонента. Полоса A центрирована при $\approx 1,8$ эВ, а $(A+J)$ -полоса при $\approx 2,1$ эВ отстоит от нее на величину энергии двухмагнного возбуждения $\hbar\omega_{2\text{mag}}$. Для $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ ($x \leq 0,6$) двухмагнный максимум в спектрах КР имеет энергию $\hbar\omega_{2\text{mag}} \approx 3J \approx 0,33$ эВ [16]. При температурном переходе

диэлектрической пленки $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ ($x \approx 0,35$) в АФ фазу как A -полоса, так и $(A+J)$ -полоса заметно сужаются [10]. Сужение полос обусловлено тем, что при уменьшении температуры ниже неелевской ($T_N \approx 170$ К) появляется спиновая щель, величина которой в слабометаллизированной фазе YBCO составляет 3–5 мэВ [17]. Было также показано [10], что ослабление поглощения на крыльях A -контра возникает вследствие эффекта сужения, который, в свою очередь, диктуется уменьшением с понижением температуры в области $T < T_N$ числа магнонов в соответствии с температурным фактором Бозе–Эйнштейна.

Эксперимент. В настоящей работе измерения абсолютных спектров поглощения и температурных изменений коэффициента поглощения были выполнены на двух металлизированных пленках $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$, которые в дальнейшем обозначаются ВН604 и ВН608. Они относятся к серии монокристаллических ВН-пленок, выращенных в Физическом институте университета г. Эрланген (Германия) в отделе проф. Г. Займанна-Ищенко (G. Saemann-Ischenko). Пленки этой серии использовались ранее при исследовании спектров поглощения при 300 К в зависимости от допирования [10]. Пленки готовились на подложках SrTiO_3 методом лазерного распыления мишеней. Они являются c -ориентированными с толщиной $l = 2300$ Å. Параметр c пленки ВН604 равен 11,722 Å и начало перехода $T_c^{\text{on}} = 51$ К, для пленки ВН608 $c = 11,705$ Å и $T_c^{\text{on}} = 74$ К. Полные ширины СП переходов по результатам магнитных измерений составляют около 1,5 К. По калибровочным данным [18], для пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ этим значениям T_c^{on} -параметра соответствуют индексы допирования $x \approx 0,45$ (ВН604) и $x \approx 0,7$ (ВН608). Измерения проводились в неполяризованном свете для вектора световой волны \mathbf{E} в CuO_2 -плоскости, $\mathbf{E} \parallel ab$.

Экспериментальная процедура измерений спектров поглощения (коэффициентов поглощения $\alpha(\omega)$) достаточно подробно изложена в [10]. Отметим сейчас только главные моменты. Для 300 К мы представим абсолютные спектры поглощения в безразмерных единицах оптической плотности αl . Эти данные получены путем сравнительных измерений спектров пропускания пленок и чистых подложек. Данные при охлаждении пленок представлены для каждой температуры в виде зависимости разностного спектра $\Delta(\alpha l) = [\alpha(T) - \alpha(T_0)] l$ от энергии квантов, где T_0 — верхняя граница температурного интервала измерений. Величина $\Delta(\alpha l)$ определялась по соотношению $\Delta(\alpha l) = \ln [t_{T_0}(\hbar\omega)/t_T(\hbar\omega)]$, где $t(\hbar\omega)$ — измерен-

ный спектр пропускания пленки при заданной температуре. Данное соотношение хорошо выполняется в пренебрежении температурными изменениями коэффициента отражения $R(\omega)$. В области энергий $\hbar\omega \geq 1,25$ эВ при охлаждении металлической фазы $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ температурные изменения R в расчете на один градус малы, $\delta R/\delta T \approx 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ [19] (абсолютный уровень отражения также небольшой, $R \approx 10\%$). Рост пропускания оказывается при этом существенно больше (не менее чем на порядок), $\delta t/\delta T \gg \delta R/\delta T$. Поэтому использование в нашей рабочей области частот приведенного выше соотношения для определения $\Delta(\alpha l)$ вполне оправданно. (Учет температурных изменений R для нахождения $\alpha(T)$ необходим в области энергий $\hbar\omega \approx 0,5$ эВ, где $R \approx 60\%$ и $\delta t/\delta T \approx \delta R/\delta T$ [20].)

Экспериментальные результаты и их обсуждение

1. Рассмотрим данные для пленки ВН604 с $T_c^{\text{он}} \approx 51$ К. На рис. 2,а представлен спектр поглощения $(\alpha l)_{\text{exp}}$ этой пленки при 300 К в спектральной области 1,25–2,8 эВ. Здесь же сплошной линией показана модельная зависимость $(\alpha l)_{\text{fit}}$, являющаяся суммой пяти компонент, на которые был разложен измеренный спектр. Отдельно эти компоненты показаны на рис. 2,б. Они описываются гауссовыми контурами, центрированными при E_0 с дисперсией σ и амплитудным коэффициентом μ_0 :

$$(\alpha l)_n = \frac{\mu_0}{\sigma\sqrt{\pi}} \exp\left[-\frac{(E - E_0)^2}{2\sigma^2}\right],$$

а также непрерывными частотными зависимостями $\alpha l(E)$. В соответствии с общим подходом к анализу спектров поглощения, о котором мы говорили выше, спектральный состав определяется следующими компонентами:

1) гауссов контур $(\alpha l)_A$ для электронного перехода из корреляционного максимума плотности состояний — A -полоса;

2) гауссов контур $(\alpha l)_{A+J}$ для перехода из корреляционного максимума с одновременным возбуждением магнитной подсистемы — $(A+J)$ -полоса;

3) гауссов контур $(\alpha l)_{2B}$ для перехода $d_{xz,yz} \rightarrow d_{x^2-y^2}$ в ионе Cu^{2+} — B_d^2 -полоса;

4) непрерывная составляющая межзонных переходов $(\alpha l)_{CT}$ с переносом заряда от кислорода к меди — ПЗ-компонента. Этой составляющей спектра лучше всего, как показывает анализ данных,

отвечает зависимость $(\alpha l)_{CT} = \mu_0^{CT} (E - E_g)^2/E$. Такая зависимость типична для прямых разрешенных переходов, когда в оптической щели имеются хвосты от плотностей состояний нижней и верхней зон [21], а также при сильном легировании, когда значительны эффекты рассеяния электронов [22]. В случае существования хвостов плотностей состояний эта зависимость для YBCO была верифицирована, например, в оптических экспериментах [23];

5) непрерывная составляющая от коротковолнового крыла СИК полосы поглощения, $(\alpha l)_{MIR}$. Мы полагаем уровень этого поглощения (рис. 2,б MIR) постоянным в области $\hbar\omega > 1,2$ эВ. Выбор частотной зависимости этой компоненты в

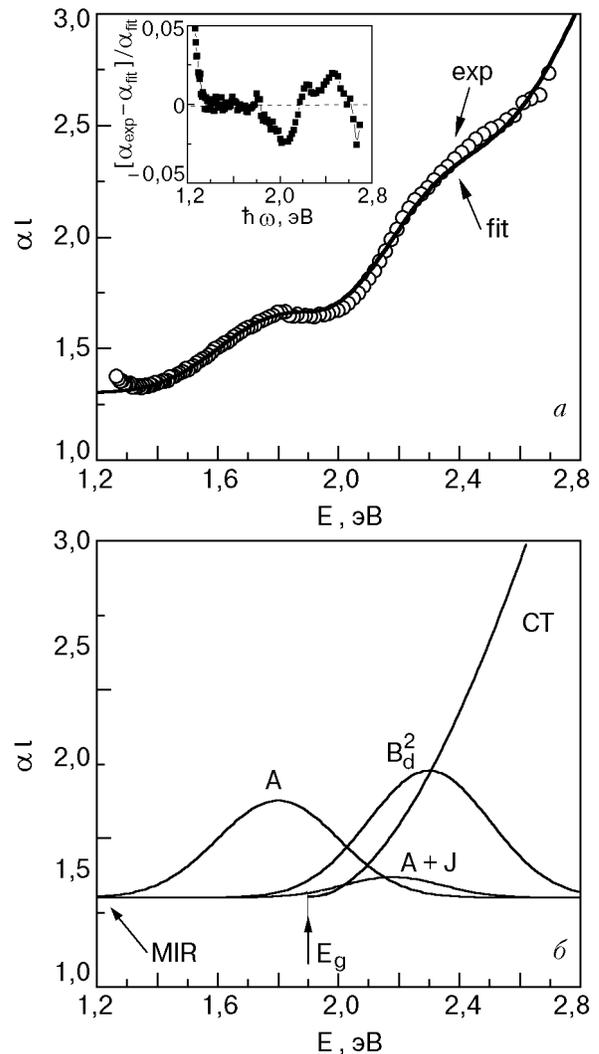


Рис. 2. Спектр поглощения $\alpha l(E)$, измеренный при 300 К для пленки ВН604 с $T_c^{\text{он}} = 51$ К (\circ), его сравнение с модельным спектром (—) (а). Вставка — относительное отличие этих спектров $(\alpha_{\text{exp}} - \alpha_{\text{fit}})/\alpha_{\text{fit}}$. Разложение модельного спектра на составляющие (б). За нулевой уровень для компонент A , B_d^1 , B_d^2 и ПЗ принят постоянный СИК-уровень поглощения $(\alpha l)_{MIR} = 2,3$.

виде, например, $(\alpha l)_{MIR} \propto 1/\omega$ слабо влияет на параметры остальных компонент.

Таким образом, суммарный многокомпонентный контур поглощения записывается в виде

$$(\alpha l)_{fit} = \sum_{n=1}^3 \frac{\mu_{0n}}{\sigma_n \sqrt{\pi}} \exp \left[-\frac{(E - E_{0n})^2}{2\sigma_n^2} \right] + \frac{\mu_0^{CT} (E - E_g)^2}{E} + (\alpha l)_{MIR}.$$

Приведем теперь количественные характеристики этого разложения, которые позволяют представить экспериментальный спектр $(\alpha l)_{exp}$ суммой $(\alpha l)_{fit} = (\alpha l)_A + (\alpha l)_{A+J} + (\alpha l)_{2B} + (\alpha l)_{CT} + (\alpha l)_{MIR}$ с точностью не хуже 4% по всему энергетическому диапазону. Относительное отличие $(\alpha l)_{exp}$ от модельного $(\alpha l)_{fit}$ показано на вставке на рис. 2, б. Итак, модельные параметры следующие:

гауссова А-полоса: $E_0^A = 1,8$ эВ, $\sigma_A = 0,19$ эВ, $\mu_0^A = 0,11$ эВ;

гауссова (А+J)-полоса: $E_0^{A+J} = 2,18$ эВ, $\sigma_{A+J} = 0,19$ эВ, $\mu_0^{A+J} = 0,02$ эВ;

гауссова B_d^{2B} -полоса: $E_0^{2B} = 2,3$ эВ, $\sigma_{2B} = 0,2$ эВ, $\mu_0^{2B} = 0,15$ эВ;

континуальная ПЗ-компонента: $E_g = 1,9$ эВ, $\mu_0^{CT} = 6$ эВ⁻¹;

уровень поглощения СИК-полосы: $(\alpha l)_{MIR} = 1,3$.

Если сравнить это модельное разложение для металлизированной пленки с разложением спектра поглощения при 300 К для диэлектрической пленки $YBa_2Cu_3O_{6+x}$ ($x \approx 0,35$) [10], то можно сделать следующие выводы. При металлизации А- и (А+J)-полосы поглощения ведут себя одинаковым образом, демонстрируя расширение своих гауссовых контуров и уменьшение их амплитудных коэффициентов. Наиболее сильно в металле ослабляется (А+J)-полоса, площадь которой для пленки ВН604 уменьшается более чем в 20 раз (во столько же раз уменьшается коэффициент μ_0^{A+J}). Существенное снижение вклада этой полосы свидетельствует о сильном затухании в металле магнонов, появляющихся при возбуждении (А+J)-перехода одновременно с рождением тяжелого дырочного носителя заряда. Как будет видно несколько ниже, для еще более металлизированной пленки ВН608 (А+J)-полоса поглощения при 300 К уже полностью отсутствует, хотя А-полоса, пусть даже ослабленная, тем не менее сохраняется. Рассмотренные изменения А- и (А+J)-полос поглощения происходят при 300 К после перехода в металлическую фазу, где сохраняются АФ корреляции ближнего порядка. Для купратных ВТСП корреляционная длина АФ флуктуаций в

металлической фазе $\xi \approx 10$ Å [2], что примерно на порядок меньше, чем в диэлектрической фазе.

В отношении локальных *dd*-переходов необходимо отметить следующее. В спектрах диэлектрической фазы при $x \approx 0,35$ и 300 К вклад от *dd*-переходов не превышает нескольких процентов [10]. В тоже время в пленке ВН604 в спектральной области 1,2–2,8 эВ из двух возможных переходов $d_{xy} \rightarrow d_{x^2-y^2}$ и $d_{xz,yz} \rightarrow d_{x^2-y^2}$ в поглощении хорошо проявляется только второй из них в виде полосы B_d^2 . Появление в слабометаллизированной пленке ВН604 максимума B_d^2 можно связать с тем, что смешивание кислородных и медных орбиталей происходит, главным образом, для состояний $d_{xz,yz}$, т. е. ковалентные связи усиливаются в поперечном относительно плоскости CuO_2 направлении. Отметим, что при переходе диэлектрик–металл в $YBa_2Cu_3O_{6+x}$ в орто-II фазе расстояние между плоскостью CuO_2 и апексным кислородом O(4) резко уменьшается (примерно на 0,1 Å), обеспечивая перетекание электронов в цепочечную плоскость CuO_x и, как следствие, дырочную металлизацию CuO_2 . Появление B_d^1 -полосы при 1,5 эВ от перехода $d_{xy} \rightarrow d_{x^2-y^2}$, т. е. усиление ковалентности уже непосредственно в активной плоскости CuO_2 , будет отчетливо видно при 300 К для пленки ВН608 с большей металлизацией.

Рассмотрим теперь поведение спектров поглощения при охлаждении пленки ВН604 с $T_c^{on} = 51$ К. На рис. 3 показаны разностные спектры $\Delta(\alpha l) = \alpha l(T) - \alpha l(T_0)$, измеренные в области 1,2–2,6 эВ относительно $T_0 = 184$ К. Как видно на рис. 3, для интервала 168–184 К наблюдается только континуальное ослабление поглощения ($\Delta(\alpha l) < 0$). Частотное поведение этой фоновой составляющей для наглядности качественно выделено пунктирной линией. Такое широкополосное изменение спектра поглощения обязано прежде всего температурному ослаблению при $T \geq 168$ К интенсивности коротковолнового крыла СИК-компоненты в видимом диапазоне частот. При охлаждении пленок $YBa_2Cu_3O_{6+x}$ коэффициент поглощения для частот $\hbar\omega < 1$ эВ в области самого максимума СИК-полосы поглощения возрастает [8,10,20]. Поэтому вблизи $\hbar\omega \approx 1$ эВ, где $\Delta(\alpha l)_{exp} \approx 0$, изменяется знак температурного хода континуального поглощения для СИК-компоненты. Мы не будем останавливаться на этом эффекте температурного перераспределения интенсивностей внутри самого СИК-контур поглощения [24], сосредоточив внимание на температурном поведении узкополосных особенностей, связанных с А- и (А+J)-полосами. Для области

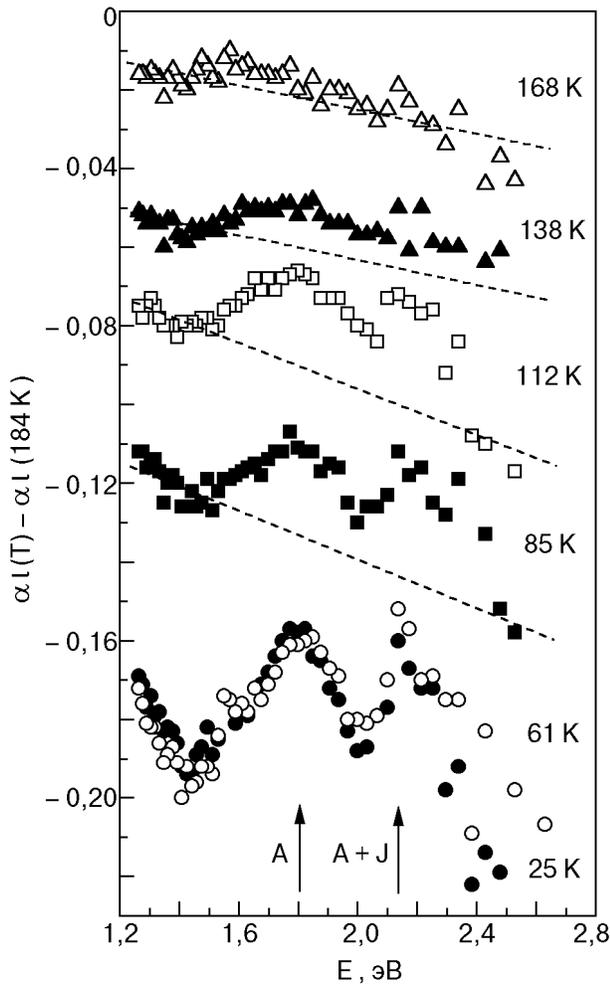


Рис. 3. Разностные спектры поглощения $[\alpha l(T) - \alpha l(T_0)]$, измеренные относительно начальной температуры $T_0 = 184$ К в пленке ВН604 с $T_c^{\text{он}} = 51$ К при температурах пленки T, K : 168 (Δ), 138 (\blacktriangle), 112 (\square), 85 (\blacksquare), 61 (\circ), 25 (\bullet). Для удобства восприятия данные при 112 К смещены вниз по оси ординат на $-0,01$; при 85 К – на $-0,03$; при 61 К и 25 К – на одинаковую величину $-0,06$.

температур $T \geq 168$ К можно утверждать, что A - и $(A+J)$ -контуры поглощения являются температурно независимыми. Однако при 138 К на континуальном фоне уже заметны спектральные особенности, связанные с температурной трансформацией A - и $(A+J)$ -полос. При дальнейшем понижении температуры от 138 до 59 К эти спектральные особенности становятся все более отчетливыми, приобретая вид отдельных полос, центрированных в максимуме A -полосы (1,8 эВ) и $(A+J)$ -полосы (2,15 эВ). На сверхпроводящем переходе с $T_c^{\text{он}} = 51$ К и в самой сверхпроводящей фазе при 25 К как континуальные, так и узкополосные спектральные изменения практически прекращаются. В этой связи укажем, что, согласно данным уже упоминавшейся работы [9], ин-

тенсивность сигнала поглощения на частоте 2 эВ перестает зависеть от температуры в СП фазе.

Несложно заключить, что появление на разностных спектрах поглощения узкополосных особенностей происходит из-за сужения A - и $(A+J)$ -полос и увеличения их амплитуд. Для иллюстрации сказанного на рис. 4 представлены экспериментальные данные $\Delta(\alpha l)_{\text{exp}} = \alpha l(25 \text{ K}) - \alpha l(184 \text{ K})$ и модельная зависимость $\Delta(\alpha l)_{\text{fit}}$ (сплошная линия), позволяющая получить количественные характеристики спектральных компонент при низких температурах. С учетом температурных изменений СИК-компоненты и A - и $(A+J)$ -полос модельная зависимость имеет вид $\Delta(\alpha l)_{\text{fit}} = \Delta(\alpha l)_{\text{fit}}(25 \text{ K}) - \Delta(\alpha l)_{\text{fit}}(184 \text{ K}) = \Delta(\alpha l)_{\text{fit}}^A + \Delta(\alpha l)_{\text{fit}}^{A+J} + \Delta(\alpha l)_{\text{fit}}^{\text{MIR}}$. Поскольку при $T > 184$ К температурные изменения незначительны, параметры модельного разложения спектра при 184 К были приняты такими же, как и при 300 К: $(\alpha l)_{\text{fit}}(184 \text{ K}) = (\alpha l)_{\text{fit}}(300 \text{ K})$ (см. выше). Модельная кривая на рис. 4, хорошо описывающая эксперимент, получена для следующих параметров спектра при низких температурах:

для СИК-компоненты $\Delta(\alpha l)_{\text{fit}}^{\text{MIR}} = -0,148 + 0,13/E^4$, т. е. в области $E \leq 1$ эВ интенсивность СИК-компоненты с понижением температуры возрастает ($\Delta(\alpha l)_{\text{fit}}^{\text{MIR}} > 0$), о чем мы уже говорили выше, но в нашей рабочей области частот эта компонента температурно ослабляется ($\Delta(\alpha l)_{\text{fit}}^{\text{MIR}} < 0$),

для A - и $(A+J)$ -полос поглощения параметры гауссовых контуров $(\alpha l)_{A,A+J}$ при охлаждении до 25 К изменяются: дисперсия A -контура уменьшается от $\sigma_A = 0,19$ эВ (300 К) до 0,165 эВ (25 К), т. е. на 10%; амплитудный коэффициент сохраняется ($\mu_0^A = 0,11$ эВ (300 К), $\mu_0^A = 0,11$ эВ (25 К)); дисперсия $(A+J)$ -контура уменьшается от $\sigma_{A+J} = 0,19$ эВ (300 К) до 0,13 эВ (25 К), т. е. на 30%; столь же существенно (на 35%) возрос амплитудный коэффициент μ_0^{A+J} (от 0,02 эВ (300 К) до 0,027 эВ (25 К)).

Таким образом, температурные изменения A - и $(A+J)$ -полос происходят между 184 и 168 К. Полосы сужаются, и их площадь увеличивается, главным образом для $(A+J)$ -полосы. При сверхпроводящем переходе спектральный состав и параметры полос поглощения прекращают изменяться, и для сверхпроводящей фазы можно говорить о том, что спектр поглощения «замораживается».

Несложно сопоставить начало этих температурных изменений в области 138–168 К с температурой T^* образования псевдощелевого состояния. Так, температурная зависимость времени спин-решеточной релаксации ядер меди $1/T_1 T \propto$

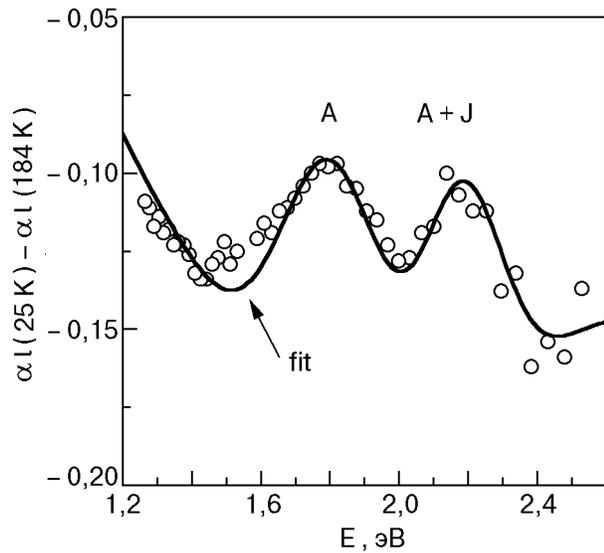


Рис. 4. Разностный спектр поглощения $[\alpha l(25\text{ K}) - \alpha l(184\text{ K})]$ пленки ВН604, измеренный для сверхпроводящего состояния при 25 К относительно начальной температуры $T_0 = 184\text{ K}$ (○). Сплошная линия – модельный разностный спектр, учитывающий температурные изменения СИК-, А-, (А+J)-компонент (см. текст).

$\propto \text{Im } \chi(\mathbf{q}, \omega) / \omega |_{\omega \rightarrow 0}$ ($\text{Im } \chi(\mathbf{q}, \omega)$ – мнимая часть магнитной восприимчивости для волнового вектора \mathbf{q}) характеризуется псевдощелевым поведением ниже $T^* = 150\text{ K}$ в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ с $T_c \approx 60\text{ K}$ [2]. При температурах ниже T^* значения $1/T_1 T$ достаточно резко уменьшаются с понижением температуры, демонстрируя снижение спектрального веса низкочастотных магнитных возбуждений. Данные по нейтронному рассеянию в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ с $T_c = 59\text{ K}$ также свидетельствуют о сильном уменьшении $\text{Im } \chi(\mathbf{q}, \omega)$ ниже $T^* = 150\text{ K}$ в низкочастотном интервале $\hbar\omega < < 16\text{ мэВ}$ [25]. Прежде чем обсуждать микроскопическую природу поведения А- и (А+J)-полос при образовании псевдощелевого и сверхпроводящего состояний, рассмотрим температурную эволюцию спектров для более металлизированной пленки ВН608.

2. На рис. 5,а изображен спектр поглощения $(\alpha l)_{\text{exp}}$ пленки ВН608 ($T_c^{\text{он}} = 74\text{ K}$), измеренный при 300 К, сплошная кривая – суммарный модельный спектр $(\alpha l)_{\text{fit}}$, а рис. 5,б – модельное разложение этого спектра на составляющие.

Это разложение позволяет описать экспериментальную кривую $(\alpha l)_{\text{exp}}$ с точностью не хуже 4% по всему спектральному интервалу 1,2–2,7 эВ (рис. 5,а, вставка). Спектр содержит пять компонент.

1. Гауссова компонента поглощения B_d^1 для перехода $d_{xy} \rightarrow d_{x^2-y^2}$ с параметрами $E_0^{1B} = 1,5\text{ эВ}$, $\sigma_{1B} = 0,36\text{ эВ}$, $\mu_0^{1B} = 0,09\text{ эВ}$.

2. Гауссова компонента поглощения А для переходов из корреляционного максимума плотности состояний с параметрами $E_0^A = 1,8\text{ эВ}$, $\sigma_A = 0,2\text{ эВ}$, $\mu_0^A = 0,045\text{ эВ}$.

3. Гауссова компонента поглощения B_d^2 для перехода $d_{xz,yz} \rightarrow d_{x^2-y^2}$ с параметрами $E_0^{2B} = 2,3\text{ эВ}$, $\sigma_{2B} = 0,2\text{ эВ}$, $\mu_0^{2B} = 0,15\text{ эВ}$. Эта полоса поглощения сохранилась такой же, как для пленки ВН604.

4. Компонента межзонных переходов с переносом заряда – ПЗ-составляющая спектра. Ее частотная зависимость не изменилась (см. выше), но величина оптической щели несколько увеличи-

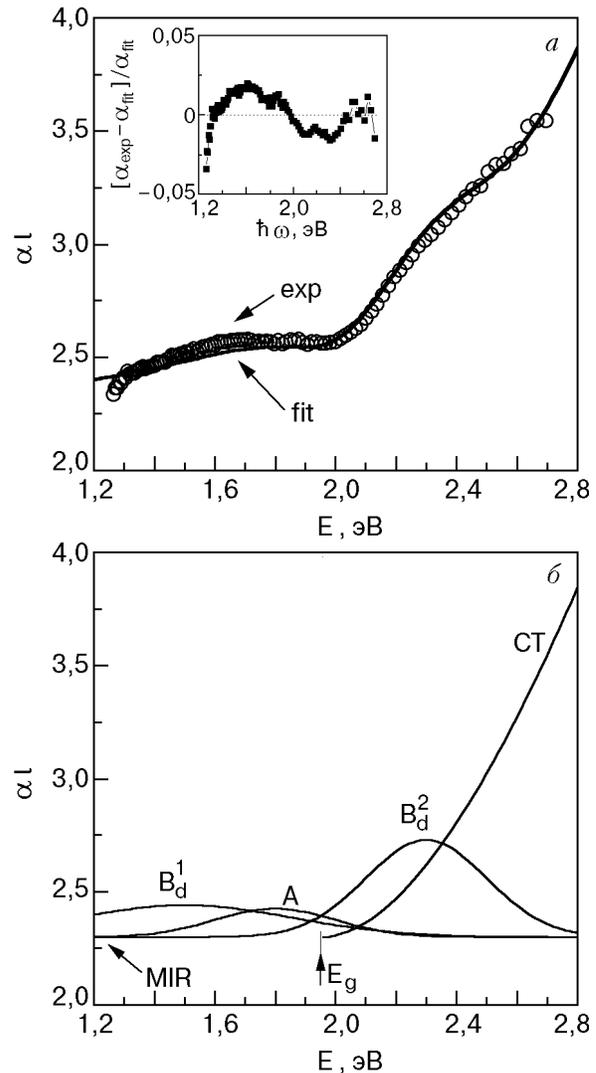


Рис. 5. Спектр поглощения $\alpha l(E)$ пленки ВН608 с $T_c^{\text{он}} = 74\text{ K}$ (○), измеренный при 300 К, и его сравнение с модельным спектром (—)(а). Вставка – относительное отличие этих спектров $(\alpha_{\text{exp}} - \alpha_{\text{fit}}) / \alpha_{\text{fit}}$. Разложение модельного спектра на составляющие (б). За нулевой уровень для компонент B_d^1 , А, B_d^2 и ПЗ принят постоянный СИК-уровень поглощения $(\alpha l)_{\text{MIR}} = 2,3$.

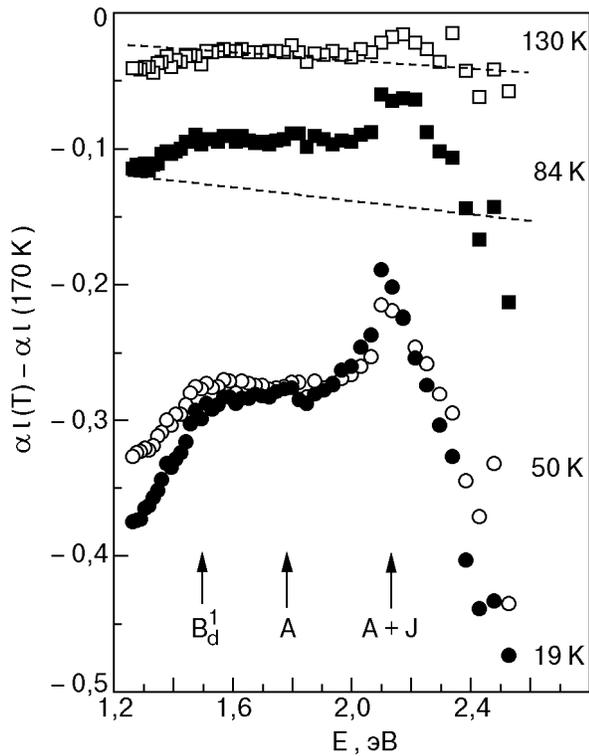


Рис. 6. Разностные спектры поглощения $[\alpha l(T) - \alpha l(T_0)]$, измеренные для пленки VN608 с $T_c^{\text{ан}} = 74 \text{ K}$ относительно начальной температуры $T_0 = 170 \text{ K}$. Температуры пленки: $T = 130 \text{ K}$ (\square), 84 K (\blacksquare), 50 K (\circ), 19 K (\bullet). Для удобства восприятия данные для $T = 84 \text{ K}$ сдвинуты вниз по оси ординат на величину (-0.03) ; а для $T = 50 \text{ K}$ и $T = 19 \text{ K}$ — на одинаковую величину (-0.20) .

лась до $E_g = 1,95 \text{ эВ}$ из-за сдвига уровня Ферми при металлизации; $\mu_0^{CT} = 6 \text{ эВ}^{-1}$.

5. Уровень СИК-поглощения: $(\alpha l)_{\text{MIR}} = 2,3$. Вклад коротковолнового крыла возрос из-за увеличения с уровнем допированием всей СИК-полосы поглощения.

При выборе разложения мы стремились минимизировать число варьируемых параметров спектрального разложения по сравнению с параметрами пленки VN604. Как несложно заметить, в разложении спектра VN608 появилась B_d^1 -полоса, отражающая усиление ковалентности в плоскости CuO_2 ; уменьшилась площадь A -полосы, что свидетельствует об уменьшении числа тяжелых дырочных носителей; полностью исчезла «магنونная» полоса поглощения $A+J$.

Разностные спектры поглощения этой пленки $\Delta(\alpha l) = \alpha l(T) - \alpha l(T_0)$ относительно температуры $T_0 = 170 \text{ K}$ представлены на рис. 6. Как видно, для области температур 130–170 K наблюдается только континуальное ослабление поглощения с понижением температуры, связанное с уменьшением интенсивности коротковолнового крыла СИК-компоненты (картина полностью аналогич-

на температурным изменениям при охлаждении пленки VN604 в интервале 168–184 K). Появление узкополосных спектральных особенностей происходит в интервале температур 84–130 K, т.е. при меньших температурах, чем в пленке VN604. В этой связи сразу укажем, что с увеличением допирования $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ температура образования псевдощелевого состояния T^* уменьшается, приближаясь к T_c [1].

Даже в качественном приближении на разностных спектрах можно выделить три узкополосные особенности, соответствующие B_d^1 -, A - и $(A+J)$ -полосам поглощения. Особый интерес, конечно, представляет факт появления при охлаждении ниже T^* полосы поглощения $(A+J)$, которая отсутствовала при комнатных температурах. В сверхпроводящей фазе при 50 и 19 K (см. рис. 6) температурные изменения спектров, также как в пленке VN604, практически отсутствуют. Впрочем, сравнивая данные при 50 и 19 K, можно все же заключить, что в СП фазе происходит некоторое спектральное перераспределение в пользу усиления $(A+J)$ -максимума, а также сужение B_d^1 -компоненты.

Для количественного описания разностного спектра VN608 на рис. 7,а сравниваются экспериментальные данные при 19 K и модельная зависимость $\Delta(\alpha l)_{\text{fit}}$ (сплошная линия). Модельная кривая получена с учетом изменения следующих компонент: $\Delta(\alpha l)_{\text{fit}} = (\alpha l)_{\text{fit}}(19 \text{ K}) - (\alpha l)_{\text{fit}}(170 \text{ K}) = \Delta(\alpha l)_{1B}^{\text{fit}} + \Delta(\alpha l)_A^{\text{fit}} + \Delta(\alpha l)_{A+J}^{\text{fit}} + \Delta(\alpha l)_{\text{MIR}}^{\text{fit}}$. Параметры модельного разложения при 170 K принимались равными параметрам при 300 K, поскольку в интервале 170–300 K температурные изменения спектра поглощения незначительны. Обратим внимание на то, что в этом модельном разложении можно полагать $(\alpha l)_{A+J}^{\text{fit}}(170 \text{ K}) = 0$, так как на абсолютных спектрах $(A+J)$ -полоса отсутствует. Четыре компоненты модельного разностного спектра $\Delta(\alpha l)_i^{\text{fit}}$ ($i \equiv 1B, A, A+J, \text{MIR}$) показаны на рис. 7,б. Следует заметить, что B_d^1 -, A - и $(A+J)$ -компоненты построены таким образом, чтобы для них нулевым уровнем являлась СИК-компонента (рис. 7, MIR).

Следующие количественные изменения достаточно точно характеризуют экспериментальный разностный спектр при 19 K.

Для СИК-компоненты: $\Delta(\alpha l)_{\text{MIR}}^{\text{fit}} = -0,28 + 0,17/E^4$ (рис. 7,б, MIR) и, следовательно, изменение направления температурного хода для компоненты происходит вблизи 0,9 эВ.

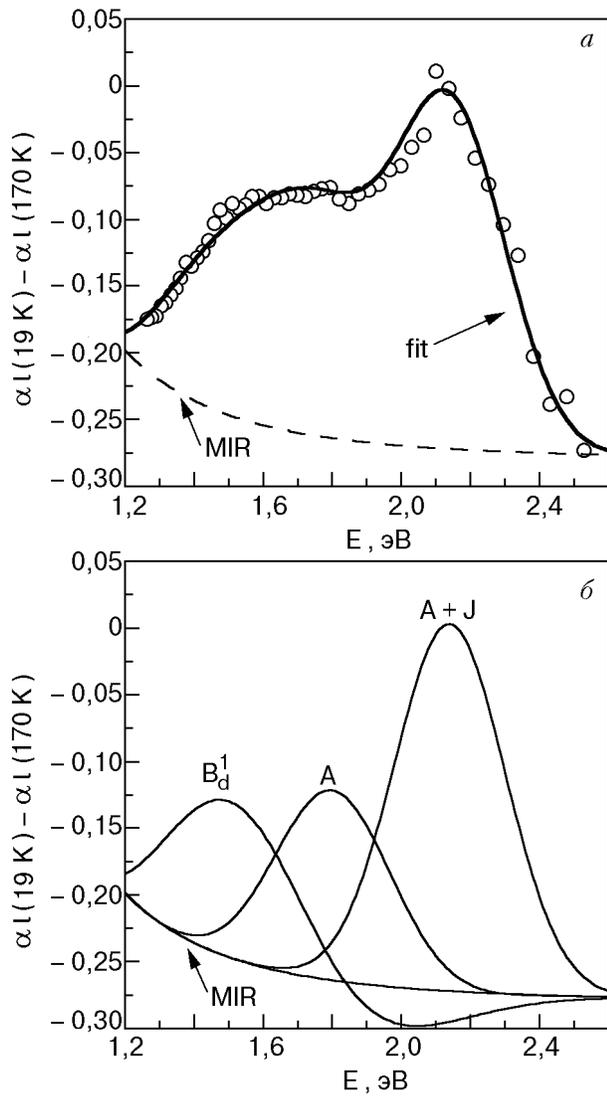


Рис. 7. Разностный спектр поглощения $[\alpha_l(19\text{ K}) - \alpha_l(170\text{ K})]$, измеренный в сверхпроводящем состоянии пленки $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.8}$ при $T = 19\text{ K}$ относительно начальной температуры $T_0 = 170\text{ K}$ (\circ). Сплошная линия (fit) показывает модельный разностный спектр (а). Спектральные составляющие модельного разностного спектра (б). Нулевым уровнем для спектральных компонент служит частотная зависимость $\Delta(\alpha)_{\text{MIR}} = [(\alpha)_{\text{MIR}}(19\text{ K}) - (\alpha)_{\text{MIR}}(170\text{ K})]$, обозначенная на рисунке MIR (см. текст).

Для ковалентной полосы B_d^1 при 1,5 эВ дисперсия контура уменьшилась от $\sigma_{1B} = 0,36\text{ эВ}$ (300 К) до 0,23 эВ (19 К), т.е. на 35%, но амплитудный коэффициент почти не изменился ($\mu_0^{1B} = 0,09\text{ эВ}$ (300 К) и 0,107 эВ (19 К)). Сохранение величины μ_0^{1B} свидетельствует о том, что степень pd -смешивания, достигнутая при 300 К уровнем допирования, при охлаждении практически не меняется.

Для A -контура, центрированного при 1,8 эВ, дисперсия уменьшилась от $\sigma_A = 0,2\text{ эВ}$ (300 К) до 0,18 эВ (19 К), т.е. на 10%, а амплитудный коэф-

фициент возрос почти в два раза от $\mu_0^A = 0,045\text{ эВ}$ (300 К) до 0,086 эВ (19 К). По сравнению с пленкой $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.8}$ амплитудный коэффициент (площадь полосы) значительно возрос при сохранении того же масштаба уменьшения величины дисперсии.

Для контура ($A+J$), поскольку он отсутствовал при 300 К, разностный спектр $\Delta(\alpha)_{A+J}^{\text{fit}}$ при 19 К представляет собой чистый гауссиан с параметрами $\sigma_{A+J} = 0,16\text{ эВ}$ и $\mu_0^{A+J} = 0,07\text{ эВ}$. Дисперсия этого контура при 19 К имеет практически то же значение, что и в диэлектрической фазе при $x \approx 0,35$, где $\sigma_{A+J} = 0,17\text{ эВ}$ [10]. При этом амплитудный коэффициент ($A+J$)-контура в пленке $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.8}$ превышает более чем в три раза его значение при низких температурах в пленке $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.4}$ с меньшей T_c .

3. Сравнивая температурные изменения спектров для двух сверхпроводящих пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.4}$ и $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.8}$, можно выделить несколько общих принципиальных моментов:

температурные изменения параметров ковалентной полосы B_d^1 , корреляционной полосы A и «магнитной» полосы ($A+J$) при охлаждении $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ от комнатных температур начинаются ниже T^* в области существования псевдощелевого состояния и происходят в интервале температур $T_c \leq T \leq T^*$;

наибольшую чувствительность к образованию псевдощелевого состояния проявляет «магнитная» полоса ($A+J$), которая появляется или усиливается в спектрах этого состояния. Все полосы поглощения при охлаждении пленок в область псевдощелевого состояния сужаются;

в сверхпроводящей фазе скорость температурной эволюции всех спектральных параметров этих полос резко уменьшается. Особо отметим, что в области существования сверхпроводящей фазы «магнитная» полоса поглощения ($A+J$) сохраняется.

Анализируя микроскопические причины температурной эволюции спектрального состава поглощения $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$, необходимо прежде всего остановиться на поведении полос поглощения A и ($A+J$), связанных с магнитными степенями свободы. Примечательно, что при $T < T^*$ происходит температурное сужение A - и ($A+J$)-контуров поглощения (после усиления этих полос при $T = T^*$). Такая картина полностью аналогична поведению этих полос поглощения в диэлектрической фазе $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ при $x \approx 0,35$, где они, будучи температурно независимыми выше T_N , начинают сужаться в АФ фазе при $T < T_N \approx 170\text{ K}$ [10]. Эффект сужения в псевдощелевом

состоянии пленок наблюдается и в ковалентной полосе B_d^1 : амплитудный коэффициент поглощения для этого dd -перехода с понижением температуры практически не меняется ($\mu_0^{1B} \approx \text{const}$), что свидетельствует о сохранении уровня pd -смешивания при низких температурах, но сам B_d^1 -контур сильно сужается. Как известно, в АФ кристаллах dd -полосы поглощения для ионов с незаполненной d -орбиталью, например для Mn^{2+} в трехмерных, двумерных и квазиодномерных магнитных структурах, с понижением температуры демонстрируют заметное сужение при $T \leq T_N$ [26,27]. Температурное сужение dd -полос поглощения при $T < T_N$ диктуется уменьшением числа магнонов в соответствии с фактором Бозе–Эйнштейна. В области температур $T < \Delta_N/k_B$ ширина dd -полос поглощения уже слабо зависит от температуры. Чувствительность dd -полос к образованию АФ состояния особенно хорошо выражена при наличии энергетической щели Δ_N в спин-волновом спектре [27].

Развивая аналогию поведения этих полос поглощения в диэлектрической АФ фазе и в металлизированной фазе $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$, мы должны признать, что образование квазищели при $T \leq T^*$ происходит именно в спектре магнитных возбуждений. В таком случае природа псевдощелевого состояния связана с решающей ролью АФ флуктуаций ближнего порядка. Величина спиновой щели для корреляционной длины АФ флуктуаций ξ равна $\Delta^* = c/\xi$ [13,28], где $c \approx 0,5$ эВ·Å — характерная скорость спиновых волн в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ [25]. Тогда для $\xi \approx 10$ Å щель $\Delta^* \approx 50$ мэВ. Для волновых векторов $q > \xi^{-1}$ спиновые волны остаются такими же, как и при наличии дальнего магнитного порядка, и не чувствительны к отсутствию АФ корреляций на расстояниях больше ξ [28,29]. При $q < \xi^{-1}$ спиновые волны являются сильно затухающими [28,29]. Согласно [28,29], спиновые волны в металлизированном состоянии ВТСП переносят спин $S = 1$ и являются беззарядовыми.

Внимания заслуживает эффект сохранения в сверхпроводящем состоянии $(A+J)$ -полосы, а также всего спектрального состава поглощения, сформированного в псевдощелевом состоянии. Этот экспериментальный результат является нетривиальным. Вполне могла бы реализоваться ситуация, когда в СП фазе $(A+J)$ -полоса исчезала, а параметры B_d^1 - и A -контуров изменялись в противоположную сторону по сравнению со своими значениями для АФ псевдощелевого состояния. Сохранение спектрального состава поглощения в СП фазе достаточно убедительно, с нашей точки

зрения, свидетельствует о совместимости в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ ближнего антиферромагнитного упорядочения и сверхпроводимости.

В связи с обсуждением этого вопроса обратим внимание на следующий результат. Мы видели, что увеличению T_c в пленке ВН 608 сопутствует усиление степени pd -смешивания, т. е. усиление с допированием интенсивности ковалентной B_d^1 -полосы поглощения. Одновременное наблюдение в спектрах поглощения $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ полосы B_d^1 и корреляционной A -полосы рассматривалось в [10] как доказательство существования в металлической фазе корреляционного полярона. Корреляционный полярон представляет собой подвижный дырочный носитель заряда, вокруг которого образуется область преимущественно ковалентных связей с ослабленными хаббардовскими корреляциями (область сильной металлизации), а вне этой области сохраняется матрица сильных хаббардовских корреляций [30]. Одновременное наблюдение в наших экспериментах A - и B_d^1 -максимумов поглощения при низких температурах может служить свидетельством того, что области АФ упорядочения сосуществуют с более металлизированными областями, которые, собственно говоря, и становятся сверхпроводящими. Другими словами, в плоскости CuO_2 эффект совместимости антиферромагнетизма и сверхпроводимости реализуется между пространственно разделенными областями (доменами), отличающимися концентрацией допированных дырок. Возможность пространственно разделенной картины сосуществования АФ упорядочения и сверхпроводимости в ВТСП экспериментально исследовалась в ряде работ (см., например, [1, 3, 16]).

Интересно также непосредственно сравнить температурное поведение A - и $(A+J)$ -полос поглощения и температурный ход однородной части магнитной восприимчивости $\chi_0(T)$. Согласно спин-волновой модели [28,29], в купратных ВТСП восприимчивость $\chi_0(T)$, будучи слабо зависящей от температуры при $T > T^*$, начинает резко уменьшаться с открытием спиновой щели при $T < T^*$, а в СП фазе при $T < T_c$ опять становится не зависящей от температуры. Несложно заметить, что такой ход $\chi_0(T)$ совпадает с температурным поведением A - и $(A+J)$ -полос поглощения. Поэтому с учетом уже сказанного выше можно полагать, что полученные в настоящей работе результаты не противоречат спин-волновому механизму высокотемпературной сверхпроводимости.

Заключение

Основным результатом работы является экспериментальное доказательство того, что псевдощелевое состояние обязано АФ упорядочению ближнего порядка с сохранением его в СП фазе. Многие нестандартные свойства медно-оксидных ВТСП в нормальной и СП фазах являются, по-видимому, проявлением фундаментальной особенности низкоразмерных систем, в которых хорошо развиты скалярные (зарядовые) и векторные (магнитные) корреляции [2]. В конечном счете эти корреляции определяют в купратных ВТСП оптические свойства, которые не встречаются в классических металлах и легированных полупроводниках. Упомянем, например, чувствительность поглощения высокоэнергетичных квантов света к СП переходу, о чем шла речь в настоящей работе; значительное перераспределение сил осцилляторов межзонных переходов в пользу внутризонных под действием очень малых уровней допирования $\approx 1\%$ [2]; различного рода неравновесные оптические явления в нормальном и СП состояниях [24]. Полученные нами оптические результаты можно рассматривать как проявление температурно-зависящего вклада хаббардовских корреляций в электронный спектр.

Вполне логично также полагать, что результаты экспериментов с $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ имеют весьма общий характер и справедливы для других купратных ВТСП с активной плоскостью CuO_2 . Принципиальные особенности электронного строения купратных ВТСП (распределение плотности состояний с корреляционным A -максимумом, сохранение в металлической фазе АФ флуктуаций ближнего порядка, образование псевдощелевого состояния) можно получить в рамках общей однозонной $2D$ модели Хаббарда (или ее модификаций) для CuO_2 -плоскости.

Первый и важный итог работы состоит, по нашему мнению, в том, что измерение температурной эволюции спектрального состава поглощения в области 1–3 эВ, где расположены оптические особенности CuO_2 -плоскости, является информативным способом диагностики нормального и СП состояний. Исследования, выполненные в этой области, показали следующее:

при охлаждении от комнатных температур металлизированных пленок $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ происходят не только количественные, но и качественные изменения спектрального состава поглощения пленок. Этим изменениям подвергаются dd -полоса поглощения ($d_{x,y} \rightarrow d_{x^2-y^2}$, $\hbar\omega \approx 1,5$ эВ); корреляционная полоса поглощения с переносом заряда, отражающая существование когерентного

максимума плотности состояний (A -полоса, $\hbar\omega \approx 1,8$ эВ); «магنونная» полоса поглощения ($(A+J)$ -полоса, $\hbar\omega \approx 2,1$ эВ), связанная с дополнительным возбуждением магнитных степеней свободы;

все температурные изменения этих узкополосных спектральных особенностей происходят при $T \leq T^*$ в области существования в нормальном состоянии $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ псевдощели в плотности электронных возбуждений;

в температурной области $T_c \leq T \leq T^*$ псевдощелевого состояния A -, $(A+J)$ - и dd -полосы поглощения сужаются, а «магنونная» полоса $(A+J)$ возникает даже при ее отсутствии в спектральном составе поглощения в области температур $T > T^*$;

характер температурного поведения A -, $(A+J)$ - и dd -полос поглощения в псевдощелевом состоянии аналогичен случаю АФ диэлектрика, что, несомненно, указывает на магнитную природу образования псевдощелевого состояния в системе АФ флуктуаций ближнего порядка;

в сверхпроводящей фазе количественные и качественные изменения спектрального состава поглощения, «накопленные» к моменту перехода в СП фазу, практически прекращаются, и в сверхпроводящей фазе спектральный состав поглощения, в том числе «магنونная» полоса $(A+J)$, сохраняется;

полученные данные и их анализ доказывают совместимость антиферромагнетизма ближнего порядка и сверхпроводимости и свидетельствуют в пользу спин-волновой природы высокотемпературной сверхпроводимости в купратных ВТСП.

Авторы выражают благодарность В. И. Фоминой за полезное обсуждение полученных результатов, а также С. В. Шевцовой за помощь при оформлении работы.

1. T. Timusk and B. Statt, *Rep. Prog. Phys.* **62**, 61 (1999).
2. M. Imada, A. Fujimori, and Y. Tokura, *Rev. Mod. Phys.* **70**, 1039 (1998).
3. Г. Г. Сергеева, Ю. П. Степановский, А. В. Чечкин, *ФНТ* **24**, 1029 (1998).
4. V. Emery, S. A. Kivelson, and O. Zachar, *Phys. Rev.* **B56**, 6120 (1997).
5. D. Pines, *Turk. J. Phys.* **20**, 535 (1996).
6. D. A. Bonn, J. D. Garrett, and T. Timusk, *Phys. Rev. Lett.* **61**, 1305 (1988).
7. I. Fugol, G. Saemann-Ischenko, V. Samovarov, Yu. Rybalko, V. Zhuravlev, Y. Ströbel, B. Holzapfel, and P. Berberich, *Solid State Commun.* **80**, 201 (1991).
8. H. L. Dewing and E. K. H. Salje, *Supercond. Sci. Technol.* **5**, 50 (1992).
9. I. Fugol, A. Ratner, V. Samovarov, M. Libin, B. Holzapfel, and G. Saemann-Ischenko, *Physica C* **235–240**, 1081 (1994).

10. В. В. Еременко, В. Н. Самоваров, В. Н. Свищев, В. Л. Вакула, М. Ю. Либин, С. А. Уютнов, *ФДТ* **26**, 739 (2000).
11. G. Yu, C. H. Lee, D. Mihailovic, A. J. Heeger, C. Fincher, N. Herron, and E. M. McCarron, *Phys. Rev.* **B48**, 7545 (1993).
12. N. Bulut, *Turk. J. Phys.* **20**, 548 (1996).
13. V. Barzykin and D. Pines, *Phys. Rev.* **B52**, 13585 (1995).
14. J. D. Perkins, R. J. Birgeneau, J. M. Graybeal, M. A. Kastner, and D. S. Kleinberg, *Phys. Rev.* **B58**, 9390 (1998).
15. D. Salamon, P. Abbamonte, Ran Liu, M. V. Klein, W. C. Lee, D. M. Ginsberg, I. I. Tartakovskii, and B. W. Veal, *Phys. Rev.* **B53**, 886 (1996).
16. А. А. Максимов, Д. А. Пронин, С. В. Зайцев, И. И. Тартаковский, М. В. Клейн, Б. У. Вил, *ЖЭТФ* **116**, 684 (1999).
17. V. L. Aksenov and V. V. Kabanov, *Phys. Rev.* **B49**, 3524 (1994).
18. J. Ye and K. Nakamura, *Phys. Rev.* **B48**, 7554 (1993).
19. M. J. Holcomb, C. L. Perry, J. P. Collman, and W. A. Little, *Phys. Rev.* **B53**, 6734 (1996).
20. Y. Yagil, F. Baudenbacher, M. Zhang, J. R. Birch, H. Kinder, and E. K. H. Salje, *Phys. Rev.* **B52**, 15582 (1995).
21. В. В. Соболев, В. В. Немошкаленко, *Электронная структура твердых тел в области фундаментального края поглощения*, Наукова думка, Киев (1992).
22. *Оптические свойства полупроводников*, Е. Ф. Гросс (ред.), Мир, Москва (1970).
23. В. Д. Окунев, З. А. Самойленко, *ФТТ* **33**, 2811 (1991).
24. I. Ya. Fugol, V. N. Samovarov, and M. Yu. Libin, *Fiz. Nizk. Temp.* **25**, 459 (1999) [*Low. Temp. Phys.* **25**, 335 (1999)].
25. J. Rossat-Mignod, L. P. Regnault, C. Vettier, P. Bourge, P. Burlet, J. Bossy, J. Y. Henry, and G. Lapertot, *Physica* **C185-189**, 86 (1991).
26. V. V. Eremenko, N. F. Kharchenko, Yu. G. Litvinenko, and V. M. Naumenko, *Magneto-Optics and Spectroscopy of Antiferromagnets*, Springer Verlag, Berlin (1992).
27. А. В. Еременко, V. V. Slavin, I. S. Kachur, and V. G. Piryatinskaya, *Fiz. Nizk. Temp.* **18**, Supplement, No. **S1**, 137 (1992).
28. A. Sokol, *J. Phys. Chem. Solids* **56**, 1679 (1995).
29. S. Sachdev, A. V. Chubukov, and A. Sokol, *Phys. Rev.* **B51**, 14874 (1995).
30. J. B. Goodenough and J. C. Zhou, *Phys. Rev.* **B42**, 4276 (1990), *ibid.* **B49**, 4251 (1994).

Optical evidence for compatibility of
antiferromagnetism and superconductivity in
 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$

V. V. Eremenko, V. N. Samovarov, V. L. Vakula,
M. Yu. Libin, and S. A. Uytunov

The evolution of absorption spectral composition was measured for the metallic $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ films with the superconducting transition temperatures $T_c = 51$ K and $T_c = 74$ K upon their cooling from 180 to 20 K. Particular attention is given to thermal changes in the two absorption bands: in the A band (≈ 1.8 eV) which reflects the emergence of holes dressed by AF fluctuations, and in the $(A + J)$ band (≈ 2.15 eV) reflecting additional (magnetic) excitation of the short-range AF order. The changes in the bands have been found to start in the normal phase at $T < T^*$ in the temperature range corresponding to the opening of the pseudogap state. It should be noted that the magnon $(A + J)$ band emerges in the pseudogap state even if it is absent at room temperature. The band parameters stop changing at the superconducting transition, and the magnon $(A + J)$ band is preserved in the superconducting phase. The results obtained are interpreted as evidence for both the magnetic nature of the pseudogap state and the coexistence of the short-range AF order with superconductivity.